

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-256240

(43)公開日 平成10年(1998) 9月25日

(51)Int.Cl.⁴

H 0 1 L 21/3065
21/768

識別記号

F I

H 0 1 L 21/302
21/90

F
K

審査請求 未請求 請求項の数80 O L (全 11 頁)

(21)出願番号 特願平9-158570

(22)出願日 平成9年(1997) 6月16日

(31)優先権主張番号 特願平9-3213

(32)優先日 平9(1997) 1月10日

(33)優先権主張国 日本 (J P)

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 深沢 正永

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内

(72)発明者 門村 新吾

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内

(72)発明者 福田 誠一

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内

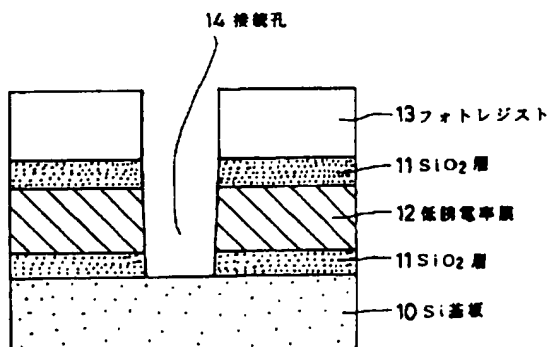
(74)代理人 弁理士 松隈 秀盛

(54)【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】 一般的な組成のエッチングガスばかりでなく、フルオロカーボン系ガスを含まないエッチングガスを用いるドライエッチングにより、層間絶縁膜に接続孔を形成することができる半導体装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 本発明は、エッチングガスを用いるドライエッチングにより、層間絶縁膜に、接続孔を形成する工程を有する半導体装置の製造方法に関するものである。低誘電率膜12は、化学構造式中にSiF結合又はCF結合を有する化合物からなる絶縁膜である。具体的には、SiOF、環状フッ素樹脂シロキサン共重合体、ポリフルオロアリアルエーテルなどを用いることができる。これらの絶縁膜を用いることにより、エッチング中に層間絶縁膜の接続孔14内から放出されるF、又はフルオロカーボン系の分子の活性種が、接続孔14内の絶縁膜のエッチングを増速させることができる。



ることができる。その場合、比誘電率が1～4の範囲にあることが望ましい。比誘電率が4よりも大きくなると、半導体デバイスのスピードが低下してしまうからであり、また、比誘電率が1より小さいものは現実に存在しないからである。

【0059】また、上述実施例では、層間絶縁膜としては、FSi結合またはFC結合を有する低誘電率膜とSiO₂膜との組み合わせたものを用いたが、組み合わせる相手はSiO₂だけでなくSi₃N₄などの他の絶縁膜を用いることができる。

【0060】また、上述実施例では、絶縁膜の組み合わせの場合を説明したが、FSi結合またはFC結合を有する低誘電率膜単体のみで層間絶縁膜を形成することもできる。

【0061】また、上述実施例ではエッチングガスとして、C₄F₈/CO/Ar/O₂の混合ガスを用いたが、この組成に限ることはなく、他の一般的な組成のエッチングガスを用いることができる。

【0062】また、エッチング中に層間絶縁膜の接続孔内から放出されるF、又はフルオロカーボン系の分子の活性種が、接続孔中の絶縁膜のエッチングを増速させることができるので、エッチングガスとしては、フルオロカーボン系ガスを含まないものを用いることもできる。フルオロカーボン系ガスを用いなくてもよいことは、環境汚染の抑制を図る観点から非常に重要な意味をもつものである。

【0063】以上のことから、本実施例によれば、エッチングガスを用いるドライエッチングにより、化学構造式中にSiF結合又はCF結合を有する化合物からなる層間絶縁膜に接続孔を形成することができる。

【0064】また、化学構造式中にSiF結合又はCF結合を有する化合物からなる第1の絶縁膜と、Si₃N₄又はSiO₂などからなる他の絶縁膜との組み合わせからなる層間絶縁膜に、接続孔を形成することができる。

【0065】また、エッチング中に層間絶縁膜の接続孔内から放出されるF、又はフルオロカーボン系の分子の活性種が、接続孔中の絶縁膜のエッチングを増速させることができるので、エッチングガスとしては、一般的な組成のエッチングガスを用いることができるばかりでなく、フルオロカーボン系ガスを含まないものを用いることもできる。

【0066】なお、本発明は上述の実施例に限らず本発明の要旨を逸脱することなくその他種々の構成を採り得ることはもちろんである。

【0067】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、エッチングガスを用いるドライエッチングにより、化学構造式中にSiF結合又はCF結合を有する化合物からなる層間絶縁膜に、接続孔を形成することができる。

【0068】また、化学構造式中にSiF結合又はCF結合を有する化合物からなる第1の絶縁膜と、Si₃N₄又はSiO₂などからなる他の絶縁膜との組み合わせからなる層間絶縁膜に、接続孔を形成することができる。

【0069】また、エッチングガスとしては、一般的な組成のエッチングガスを用いることができるばかりでなく、フルオロカーボン系ガスを含まないものを用いることもできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例により、層間絶縁膜に形成した接続孔を示す概略断面図である。

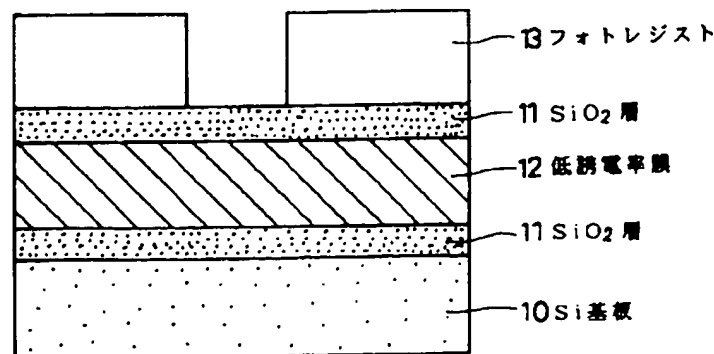
【図2】本発明の実施例に用いたサンプルの構造を示す概略断面図である。

【図3】本発明の実施例との比較のために用いた層間絶縁膜に、形成することを試みた接続孔を示す概略断面図である。

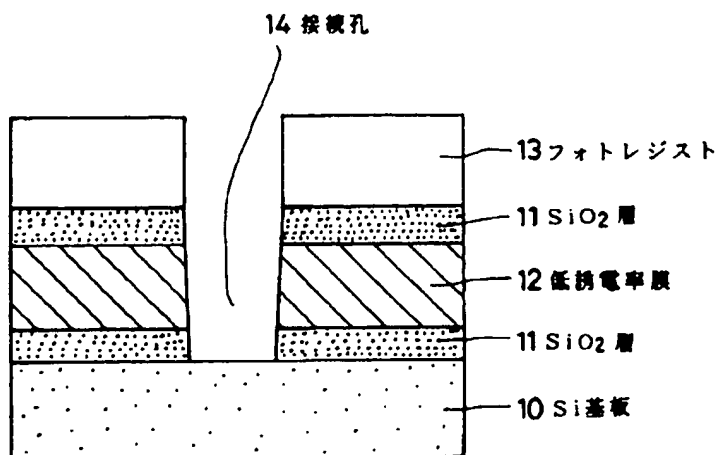
【符号の説明】

10 Si基板、11 SiO₂層、12 低誘電率膜、13 フォトレジスト、14 接続孔

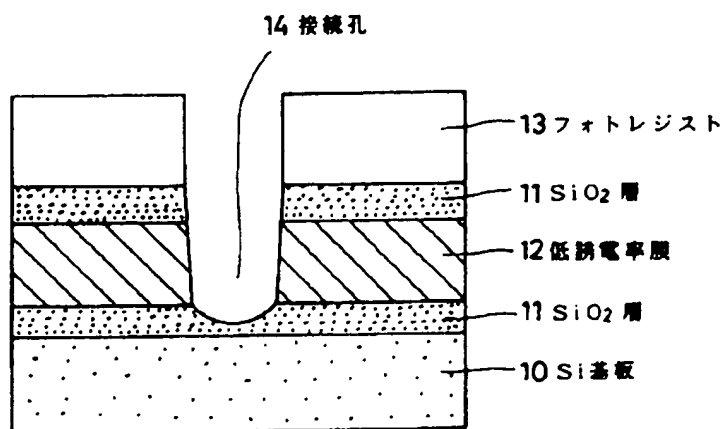
【図2】



【図1】



【図3】



* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

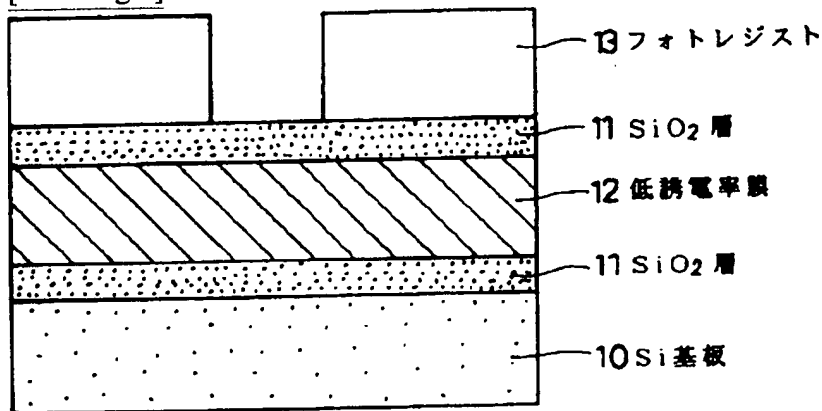
2. **** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

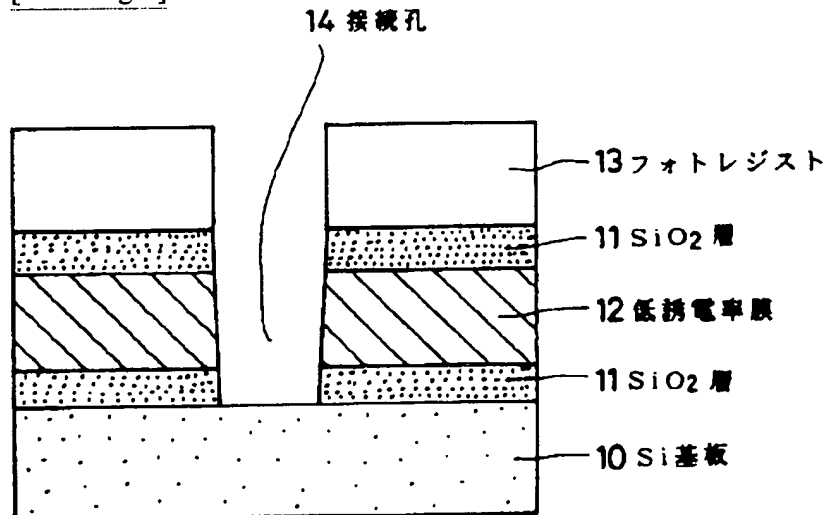
IDS 19+20

DRAWINGS

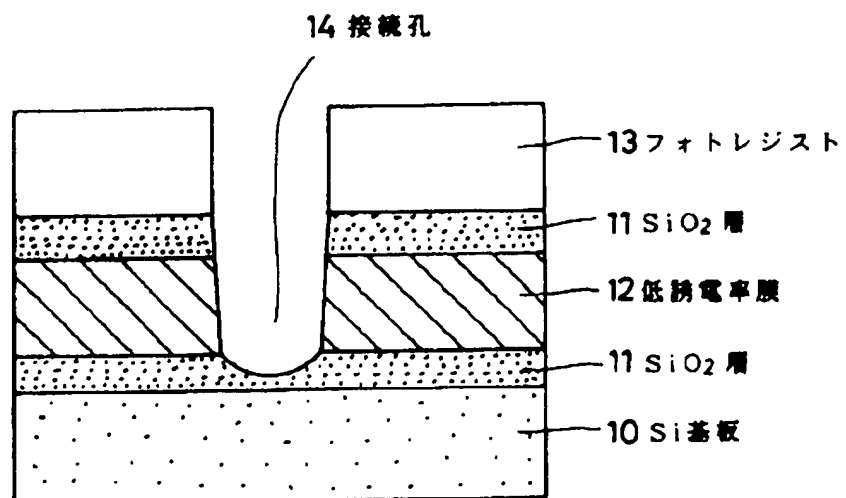
[Drawing 2]



[Drawing 1]



[Drawing 3]



[Translation done.]